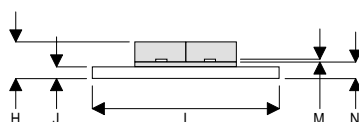
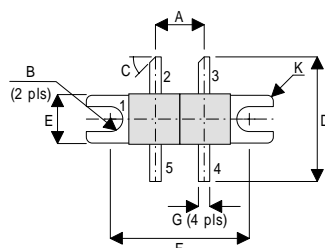


MECHANICAL DATA



DK

PIN 1 SOURCE (COMMON) PIN 2 DRAIN 1  
 PIN 3 DRAIN 2 PIN 4 GATE 2  
 PIN 5 GATE 1

DIM	mm	Tol.	Inches	Tol.
A	6.45	0.13	0.254	0.005
B	1.65R	0.13	0.065R	0.005
C	45°	5°	45°	5°
D	16.51	0.76	0.650	0.03
E	6.47	0.13	0.255	0.005
F	18.41	0.13	0.725	0.005
G	1.52	0.13	0.060	0.005
H	4.82	0.25	0.190	0.010
I	24.76	0.13	0.975	0.005
J	1.52	0.13	0.060	0.005
K	0.81R	0.13	0.032R	0.005
M	0.13	0.02	0.005	0.001
N	2.16	0.13	0.085	0.005

**GOLD METALLISED  
 MULTI-PURPOSE SILICON  
 DMOS RF FET  
 20W – 28V – 1GHz  
 PUSH-PULL**

**FEATURES**

- SIMPLIFIED AMPLIFIER DESIGN
- SUITABLE FOR BROAD BAND APPLICATIONS
- VERY LOW  $C_{rss}$
- SIMPLE BIAS CIRCUITS
- LOW NOISE
- HIGH GAIN – 10 dB MINIMUM

**APPLICATIONS**

- HF/VHF/UHF COMMUNICATIONS  
 from 1MHz to 2 GHz

**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS** ( $T_{case} = 25^{\circ}C$  unless otherwise stated)

$P_D$	Power Dissipation	83W
$BV_{DSS}$	Drain – Source Breakdown Voltage *	65V
$BV_{GSS}$	Gate – Source Breakdown Voltage *	$\pm 20V$
$I_{D(sat)}$	Drain Current *	4A
$T_{stg}$	Storage Temperature	$-65$ to $150^{\circ}C$
$T_j$	Maximum Operating Junction Temperature	$200^{\circ}C$

\* Per Side

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS** ( $T_{case} = 25^{\circ}C$  unless otherwise stated)

Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
<b>PER SIDE</b>					
$BV_{DSS}$ Drain–Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0$ $I_D = 10mA$	65			V
$I_{DSS}$ Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 28V$ $V_{GS} = 0$			1	mA
$I_{GSS}$ Gate Leakage Current	$V_{GS} = 20V$ $V_{DS} = 0$			1	$\mu A$
$V_{GS(th)}$ Gate Threshold Voltage *	$I_D = 10mA$ $V_{DS} = V_{GS}$	1		7	V
$g_{fs}$ Forward Transconductance *	$V_{DS} = 10V$ $I_D = 0.8A$	0.72			S
<b>TOTAL DEVICE</b>					
$G_{PS}$ Common Source Power Gain	$P_O = 20W$	10			dB
$\eta$ Drain Efficiency	$V_{DS} = 28V$ $I_{DQ} = 0.8A$	40			%
VSWR Load Mismatch Tolerance	$f = 1GHz$	20:1			—
<b>PER SIDE</b>					
$C_{iss}$ Input Capacitance	$V_{DS} = 0$ $V_{GS} = -5V$ $f = 1MHz$			48	pF
$C_{oss}$ Output Capacitance	$V_{DS} = 28V$ $V_{GS} = 0$ $f = 1MHz$			24	pF
$C_{rss}$ Reverse Transfer Capacitance	$V_{DS} = 28V$ $V_{GS} = 0$ $f = 1MHz$			2	pF

\* Pulse Test: Pulse Duration = 300  $\mu s$  , Duty Cycle  $\leq 2\%$

**HAZARDOUS MATERIAL WARNING**

The ceramic portion of the device between leads and metal flange is beryllium oxide. Beryllium oxide dust is highly toxic and care must be taken during handling and mounting to avoid damage to this area.

**THESE DEVICES MUST NEVER BE THROWN AWAY WITH GENERAL INDUSTRIAL OR DOMESTIC WASTE.**

**THERMAL DATA**

$R_{THj-case}$	Thermal Resistance Junction – Case	Max. 2.1 $^{\circ}C / W$
----------------	------------------------------------	--------------------------

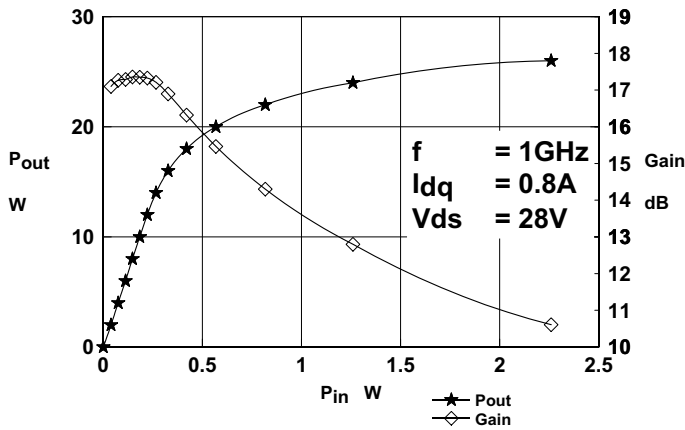


Figure 1

Output Power and Gain vs. Input Power.

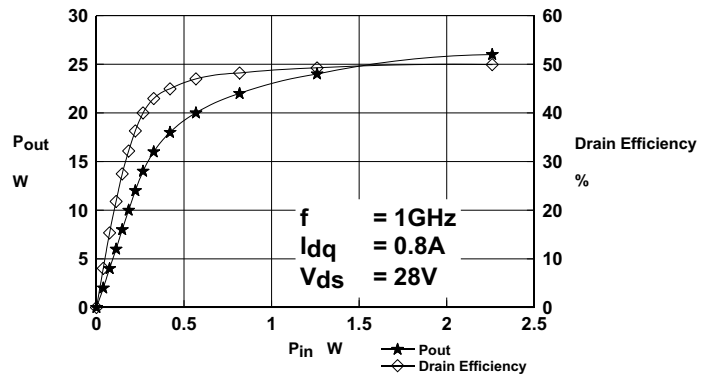


Figure 2

Output Power and efficiency vs. Input Power.

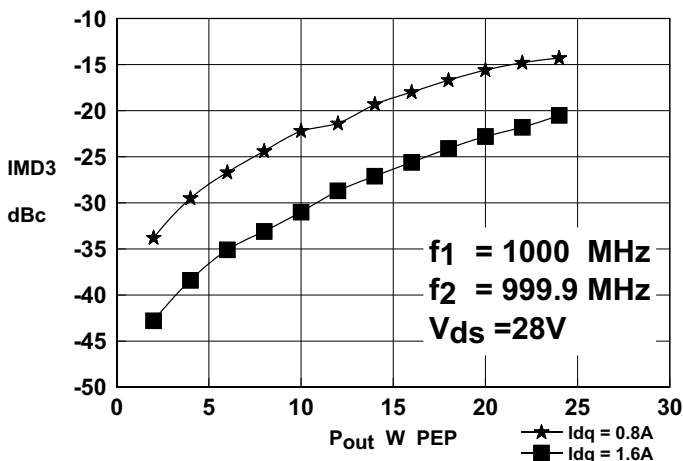


Figure 3

IMD vs. Output Power.

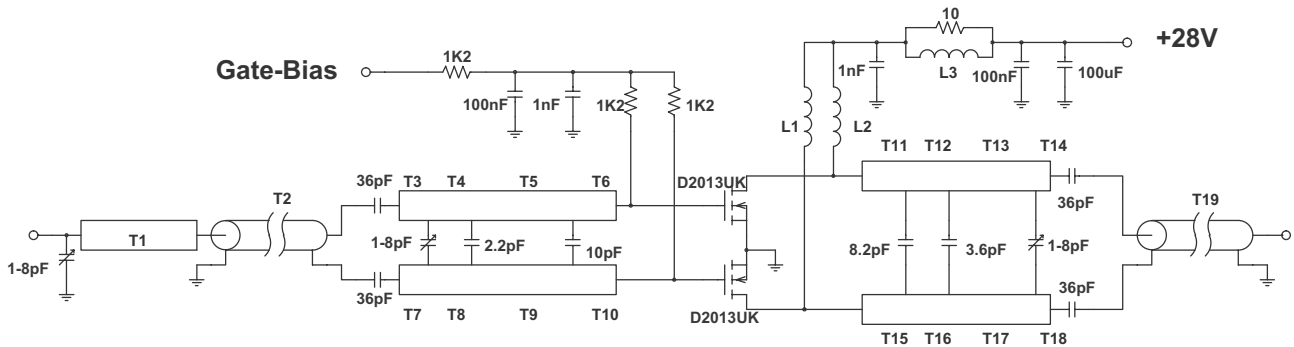
OPTIMUM SOURCE AND LOAD IMPEDANCE

Frequency MHz	Z <sub>S</sub> Ω	Z <sub>L</sub> Ω
1000MHz	1.3 - j4.6	2.5 - j2.6

Typical S Parameters

! Vds=28V, Idq=0.8A  
# MHz S MA R 50

!Freq !MHz	S11		S21		S12		S22	
	mag	ang	mag	ang	mag	ang	mag	ang
100	0.841	-122	24.547	98	0.01318	13	0.49	-94
200	0.871	-146	11.482	69	0.01	0	0.61	-125
300	0.891	-156	6.683	52	0.00653	10	0.708	-137
400	0.902	-163	4.365	40	0.00596	49	0.767	-146
500	0.923	-170	3.055	27	0.00891	71	0.813	-155
600	0.933	-174	2.113	22	0.01349	79	0.851	-165
700	0.955	-175	1.758	19	0.01862	85	0.881	-166
800	0.955	-177	1.413	12	0.02344	82	0.902	-170
900	0.966	-179	1.161	5	0.02851	80	0.902	-177
1000	0.955	-177	0.944	3	0.03236	80	0.902	-179



### 1000MHz Test Fixture

Substrate 0.8mm thick PTFE/glass

All microstrip lines  $W = 2.7\text{mm}$

T1	23mm
T2, T19	50MM 50 Ohm UT34 semi-rigid coax
T3, T7	6mm
T4, T8	8mm
T5, T9	15mm
T6, T10	9mm
T11, T15	8mm
T12, T16	7mm
T13, T17	11mm
T14, T18	5mm

L1, L2 6 turns of 24swg enamellid copper wire, 3mm i,d.

L3 1.5 turn 24 swg enamelled copper wire on Siemens B62152-A7x 2 hole core

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TT Electronics:](#)

[D2013UK](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)